ЛАТЕНТНЫЕ ТРЕКИ БЫСТРЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ В НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ Y4Al2O9

А.К. Мутали^{1), 2), 3)}, А.Д. Ибраева^{2), 3)}, В.А. Скуратов³⁾, А.С. Сохацкий³⁾, Е. Корнеева³⁾, Р.А. Рымжанов^{2), 3)}, А. Янсе ван Вуурен⁴⁾, Ж.Г. О'Коннелл⁴⁾, М.В. Здоровец^{1), 2)}

¹⁾Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 010000 Нур-Султан, Казахстан, mutali@jinr.ru

²⁾Астанинский филиал Института ядерной физики, 010008 Нур-Султан, Казахстан, а.d.ibrayeva@gmail.com, rymzhanov@jinr.ru, mzdorovets@gmail.com

³⁾Лаборатория ядерных реакций им. Г.Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований, 141980 Дубна, Россия, skuratov@jinr.ru, sohatsky@jinr.ru, ekorneeva@jinr.ru

⁴⁾Центр ВР ПЭМ, Университет Нельсона Манделы, Порт Элизабет, Южная Африка, аrnojvv@gmail.com, jacques.oconnell@gmail.com

В работе представлены результаты исследования структурных изменений алюмоиттриевого оксида $Y_4Al_2O_9$ (YAM), облученного в режиме одиночных треков ионами Ві и Хе в широком диапазоне удельных ионизационных потерь энергии, полученные с помощью просвечивающей и сканирующей просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (С/ПЭМ). Установлено, что результатом воздействия высокоэнергетических тяжелых ионов является образование аморфных латентных треков, диаметр которых увеличивается с ростом потерь энергии на электронное торможение. На основе анализа зависимости размера треков от уровня ионизационных потерь энергии определено пороговое значение для образования треков в нанокристаллическом YAM, составляющее $S_{et} \sim 7-8$ кэВ/нм.

Ключевые слова: Y₄Al₂O₉; YAM; ПЭМ; быстрые тяжелые ионы; латентные треки; нанокристаллический.

SWIFT HEAVY ION IRRADIATION INDUCED LATENT TRACKS IN NANOCRYSTALLINE Y₄Al₂O₉

A.K. Mutali^{1), 2), 3)}, A.D. Ibrayeva^{2), 3)}, V.A. Skuratov³⁾, A.S. Sohatsky³⁾, E. Korneeva³⁾, R.A. Rymzhanov^{2), 3)}, A. Janse van Vuuren⁴⁾, J.H. O'Connell⁴⁾, M.V. Zdorovets^{1), 2)}

¹⁾L.N. Gumilyov Eurasian National University, 010000 Nur-Sultan, Kazakhstan, mutali@jinr.ru

²⁾Astana branch of the Institute of Nuclear Physics, 010008 Nur-Sultan, Kazakhstan, a.d.ibrayeva@gmail.com, rymzhanov@jinr.ru, mzdorovets@gmail.com

³⁾G.N. Flerov Laboratory of Nuclear Reactions of Joint Institute for Nuclear Research, 141980 Dubna, Russia, skuratov@jinr.ru, sohatsky@jinr.ru, ekorneeva@jinr.ru

⁴⁾Centre for HRTEM, Nelson Mandela Metropolitan University, 77000 Port Elizabeth, South Africa, arnojvv@gmail.com, jacques.oconnell@gmail.com

This work is aimed to study the swift heavy ion induced structural changes in nanostructured monoclinic yttrium aluminum oxide $Y_4Al_2O_9$ (YAM) using high-resolution scanning/transmission electron microscopy (S/TEM). YAM with monoclinic crystallographic structure and space group $P2\sqrt{c}$ (No. 14) is one of three crystalline phases in the Y-Al-O system and has a unique combination of high melting point (2020 °C), low density (4.44 g/cm³), low high-temperature thermal conductivity (the minimum thermal conductivity is 1.13 W·m⁻¹K⁻¹) and relative low Young's modulus (191 GPa), which endure it as a candidate material for an inert matrix fuel hosts. YAM samples were irradiated with Bi and Xe ions having energies ranging from 156 to 714 MeV and electronic stopping powers - from 5 to 35 keV/nm at the IC-100 and U-400 FLNR JINR cyclotrons and the DC-60 cyclotron at the IRC INP. The ion fluence corresponding to the "individual tracks" regime was 5×10^{11} cm⁻². S/TEM structural examinations showed that swift heavy ion induced latent tracks in YAM particles are continuous and amorphous. Ion track sizes larger than expected at the smallest energy loss for Xe ions and smaller track diameters at the highest energy loss for Bi ions are associated with the so-called "velocity effect". It is suggeste that the complexity of the crystal structure plays a significant role in formation of ion tracks in this material. The threshold value of electron stopping power for track formation in nanocrystalline YAM was found to be equal $S_{et} \sim 7-8$ keV/nm.

Keywords: Y₄Al₂O₉; YAM; TEM; swift heavy ions; latent tracks; nanocrystals; radiation defects.

Введение

В последние годы, радиационная стойкость соединений Y-Al-O привлекает значительное внимание. В частности, это связанно с тем, что эти материалы входят в состав наночастиц в некоторых дисперсноупрочненных оксидами сплавах. Стабильность таких частиц к различным видам излучения, включая ионы высоких энергий, имеет большое практическое значение. Для данного вида радиационного воздействия характерно образование специфических радиационных повреждений - латентных треков, которые представляют собой протяженные разупорядоченные области вдоль ионной траектории с поперечным размером в несколько нанометров, способные существенным образом повлиять на характеристики материала и, следовательно, на условия его практического применения.

Алюмоиттриевый оксид $Y_4Al_2O_9$ (YAM) с моноклинной кристаллической структурой и пространственной группой $P2_1/c$ (N_214) является одной из трех кристаллических фаз в системе Y-Al-O [1, 2]. Другие фазы в системе: иттриево-алюминиевый перовскит YAlO₃ (YAP) существует в кубической форме со структурой граната [3], и иттриево-алюминиевый гранат $Y_3Al_5O_{12}$ (YAG) имеет ромбическую структуру искаженного перовскита [4].

Y₄Al₂O₉ (YAM) по сравнению с YAG и ҮАР имеет более высокую температуру плавления, 2020°C против 1940°C и 1950°С соответственно [5-9] и меньшую плотность (4.44 г/см^3) . Также он характеризуется достаточно низкой теплопроводностью $(1.13 \text{ B}\cdot\text{M}^{-1}\text{K}^{-1})$, достаточно хоромеханическими шими свойствами (константа Юнга 191 ГПа) [10]. настоящее время практически нет данных о радиационно-стимулированных изменениях в ҮАМ. Так, воздействие тяжелых ионов высоких энергий на структуру наночастиц YAM ранее не исследовалось, в отличие от кристаллов YAG и YAP [11-131.

Целью данной работы является анализ

микроструктуры наночастиц YAM, облученных быстрыми тяжелыми ионами методами высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии.

Материалы и методы исследования

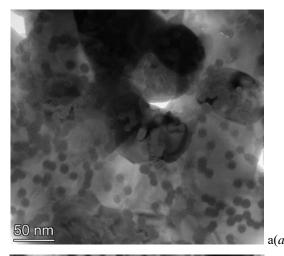
В данной работе объектами исследования были нанокристаллические $Y_4Al_2O_9$, синтезированные в образцы Научно-исследовательском физико-техническом институте Нижегородского государственного университета. Наночастицы, осажденные на ПЭМ гриды, облучались ионами ¹³²Хе с энергиями 156 и 220 МэВ и ионами 209Ві с энергией 714 МэВ при комнатной температуре на циклотронах ИЦ-100, У-400 в ЛЯР ОИЯИ (Дубна, Россия) и ДЦ-60 в АФ ИЯФ (Нур-Султан, Казахстан). Для расширения диапазона удельных ионизационных потерь энергии облучение проводилось с использованием специальных поглощаю-щих фильтров в виде алюминиевых фольг. Флюенс ионов для всех образцов составлял $5 \cdot 10^{11}$ см⁻².

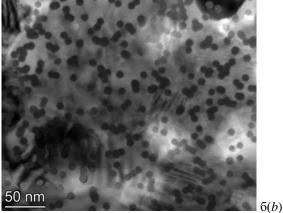
Структура облученных образцов исследовалась в ЛЯР ОИЯИ на сканирующем/просвечивающем электронном микроскопе Talos^{тм} F200i S/TEM, работающем при напряжении 200 кВ. Соответствующий анализ С/ПЭМ изображений проводился с применением программного пакета Velox^{тм}.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведены светлопольные и темнопольные ПЭМ снимки структуры нанокристаллического YAM, облученного ионами Ві с энергией 714 МэВ и Хе с энергиями 156 и 55 МэВ. Исследования структуры методами ПЭМ показали, что образованные треки представляют собой аморфные образования в частицах YAM, и диаметры треков увеличиваются с увеличением тормозной способности.

Экспериментальные данные по размерам треков в нанокристаллическом YAM в зависимости от уровня удельных ионизационных потерь энергии ионов висмута и ксенона, S_e , приведены в таблице 1





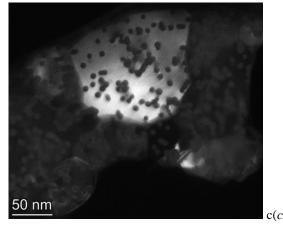


Рис. 1. Светлопольные и темнопольные ПЭМ снимки латентных треков в нанокристаллическом YAM, облученном ионами: $a-Bi\ 714\ MэB;\ 6-Xe\ 156\ MэB;\ c-Xe\ 55\ MэB$

Fig. 1. Brightfield and darkfield TEM images of latent tracks in nanocrystalline YAM irradiated with: a - 714 MeV Bi; b - 156 MeV Xe; c - 55 MeV Xe

и рис. 2. Отметим, что подобные результаты получены впервые в мире.

Большие размеры треков при низких энергиях ионов Хе, и уменьшение треков

Таблица 1. Размеры треков в n-YAM, облученном ионами Ві и Хе до флюенса 5·10¹¹ см⁻²

			7 T			
Table	1.	Track	measurements	in	n-YAM	irradiated
with B	i a	nd Xe i	ons with fluence	ce 5	·1011 cm	-2

Ион	Энергия, МэВ	S _e , кэВ/нм	Радиус трека	Станд-е отклонение
²⁰⁹ Bi	714	35.27	4.83	0.65
	354	30.87	5.32	0.5
	287	28.64	5.22	0.5
	241	27.27	5.02	0.54
	164	23.54	4.46	0.52
	106	19.12	3.21	0.61
	83	16.68	2.54	0.58
¹³² Xe	220	22.21	3.65	0.55
	156	20.4	3.60	0.6
	98	17.85	3.55	0.68
	79	16.52	3.58	0.57
	55	14.15	3.35	0.62
	53	13.81	3.30	0.57
	38	11.56	3.12	0.55
	34	10.8	2.86	0.58
	20	7.43	2.38	0.6

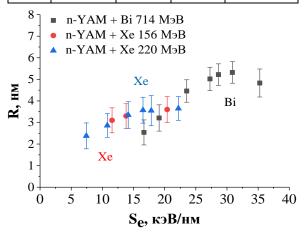


Рис. 2. Зависимость радиуса треков в YAM от уровня электронного торможения Fig. 2. Track radii in YAM as a function of electronic stopping power

при наибольшей энергии ионов Ві связывают с так называемым «эффектом скорости», в соответствии с которым при одинаковой величине Se, больший радиус трека наблюдается для ионов с меньшей скоростью и меньшие радиусы для ионов с высокой скоростью. Особенно ярко этот эффект проявляется для энергий иона, находящихся симметрично относительно Брэгговского пика электронных потерь энергии иона [14, 15].

Диаметры треков в YAM, облученных ионами Xe, и в YAG, облученных ионами

Хе 167 МэВ [13], очень похожи, тогда как по сравнению с ҮАР, диаметры треков примерно В полтора раза больше. Результаты указывают на то, что тип кристаллической структуры, по-видимо-му, играет значительную роль в параметрах треков [16]. В YAM с более сложной элементарной ячейкой, содержащей 60 атомов, формируются треки большего размера, тогда как в ҮАР с намного более простой элементарной ячейкой, содержащей 20 атомов, радиус треков намного меньше.

В наших экспериментах треки не наблюдались после облучения ионами Ві с потерями энергии ~7 кэВ/нм и Хе (~5.2 кэВ/нм). Следовательно, можно предположить, что пороговое значение уровня электронного торможения, требуемое для образования треков в YAM, должно быть в интервале энергий 7-8 кэВ/нм.

Заключение

Установлен размер латентных треков с помощью С/ПЭМ облученных высокоэнергетическими ионами висмута и ксенона. Впервые установлено, что облучение быстрыми тяжелыми ионами приводит к образованию аморфных латентные треков в нанокристаллическом YAM. Пороговое значение ионизационных потерь для образования треков находится в интервале 7-8 кэВ/нм.

Работа выполнена в рамках проекта ИРН (АР09058081) при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Библиографические ссылки/ References

- 1. Wang Y., Hrubiak R., Turczynski S., Pawlak D.A., Malinowski M., Wlodarczyk D. et al. Spectroscopic properties and martensitic phase transition of Y₄Al₂O₉:Ce single crystals under high pressure. *Acta Materialia* 2019; 165: 346-361.
- 2. Girish H.N., Zhu C., Ma F.F., Shao G.Q. Synthesis of Cubic Yttrium Aluminum Garnet (YAG) Powders by Co-precipitation and Two-Step Calcinations. *AIP Conference Proceedings* 2017; 1829: 020019.
- 3. Yoder H.S., Keith M.L. Complete substitution of aluminum for silicon: The system 3MnO·Al₂O₃·3SiO₂-3Y₂O₃·5Al₂O₃, *American Mineralogist* 1951; 36(7–8): 519-533.

- 4. Geller S., Wood E.A. Crystallographic studies of perovskite-like compounds. I. Rare earth orthoferrites and YFeO₃, YCrO₃, YAlO₃. *Acta Crystallographica* 1956; 9: 563-568.
- 5. Zhou Y., Xiang H., Lu X., Zhihai F., Zhongping L. Theoretical prediction on mechanical and thermal properties of a promising thermal barrier material: Y₄Al₂O₉. *Journal of Advanced Ceramics* 2015; 4(2): 83-93.
- 6. Zhan X., Li Z., Liu B., Jingyang W., Yanchun Z., Zijun H. Theoretical prediction of elastic stiffness and minimum lattice thermal conductivity of Y₃Al₅O₁₂, YAlO₃ and Y₄Al₂O₉. Journal of the American Ceramic Society 2012; 95(4): 1429-1434.
- Li Z., Liu B., Wang J.M., Sun L.C., Wang J.Y., Zhou Y.C. et al. First-principle study of point defects in stoichiometric and nonstoichiometric Y₄Al₂O₉. *Journal of Materials Science & Technology* 2013; 29(12): 1161-1165.
- 8. Mah T., Petry M.D. Eutectic composition in the pseudobinary of Y₄Al₂O₉ and Y₂O₃. *Journal of the American Ceramic Society* 1992; 75(7): 2006-2009.
- 9. Zhou X., Xu Z., Fan X., Sumei Zh., Xueqiang C., Limin H. Y₄Al₂O₉ ceramics as a novel thermal barrier coating material for high temperature applications. *Materials Letters* 2014; 134: 146-148.
- 10. Yanchun Z., Xinpo L., Huimin X., Zhihai F. Preparation, mechanical, and thermal properties of a promising thermal barrier material: Y₄Al₂O₉. *Journal of Advanced Ceramics* 2015; 4(2): 94-102.
- 11. Izerrouken M., Meftah A., Nekkab M. Radiation damage induced by swift heavy ions and reactor neutrons in Y₃Al₅O₁₂ single crystals. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B* 2007; 258(2): 395-402.
- 12. Rodriguez M.D., Li W.X., Chen F., Trautmann C., Bierschenk T., Afra B. SAXS and TEM investigation of ion tracks in neodymium-doped yttrium aluminum garnet. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B* 2014; 326: 150-153.
- 13. Janse van Vuuren A., Saifulin M.M., Skuratov V.A., O'Connell J.H., Aralbayeva G., Dauletbekova A. et al. The influence of stopping power and temperature on latent track formation in YAP and YAG. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B* 2019; 460: 67-73.
- 14. Chadderton L.T. Nuclear tracks in solids: registration physics and the compound spike. *Radiation Measurements* 2003; 36(1-6): 13-34.
- 15. Lang M., Hasenkamp W., Ishikawa N., Medvedev N., Neumann R., Papaleo R. et al. Influence of ion velocity on the track morphology in dark mica. *GSI Scientific Report* 2005; 3: 343.
- 16. Park S., Lang M., Tracy C.L., Zhang J., Zhang F., Trautmann C. et al. Response of Gd₂Ti₂O₇ and La₂Ti₂O₇ to swift-heavy ion irradiation and annealing. *Acta Materialia* 2015; 93: 1-11.